

Михаил Яковлевич Дашевский

(к 80-летию со дня рождения)



23 октября 2011 года исполнилось 80 лет Михаилу Яковлевичу Дашевскому — профессору кафедры материаловедения полупроводников Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета), академику Азиатско-Тихоокеанской академии материалов, крупному ученому в области физического материаловедения и металлургии полупроводников, широко известному у нас в стране и за рубежом.

Потомственный металлург, М. Я. Дашевский в 1954 г. с отличием окончил Московский институт стали по специальности „электрометаллургия стали и ферросплавов“ и был направлен на работу в Институт металлургии им. А. А. Байкова АН СССР (ИМЕТ). В ИМЕТ он работал в течение 11 лет в созданной одной из первых в стране академических лабораторий полупроводниковых материалов. Новая по тому времени тематика лаборатории имела важнейшее значение для народного хозяйства и обороны страны. В 1964 г. М. Я. Дашевский защитил кандидатскую диссертацию. В начале 70-х годов он проходил стажировку в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе АН СССР в лаборатории Д. Н. Наследова в группе В. В. Голованова. Уже тогда при исследовании электро-

физических и структурных свойств InSb проявились такие качества М. Я. Дашевского, как широкая эрудиция, любознательность, доброжелательность, обаяние, преданность любимой работе, готовность оказать помощь. С 1963 г. работу в ИМЕТ он совмещает с преподаванием в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) на кафедре материаловедения полупроводников, а в 1965 г. полностью переходит на работу в МИСиС, где работает сначала доцентом, а затем профессором этой кафедры. В МИСиС развернулись его способности ученого, педагога, автора фундаментальных учебников и учебных пособий, методиста, организатора и воспитателя. Многогранность его деятельности уникальна. Вклад М. Я. Дашевского в материаловедение и металлургию полупроводников получил широкую известность в кругах ученых и работников промышленности. Это — исследования в области выращивания, изучения физических свойств и структурных особенностей легированных электроактивными и изовалентными добавками совершенных монокристаллов алмазоподобных полупроводников (Si, Ge, InSb, GaSb), с однородным или заданным распределением легирующих добавок; исследования в области выращивания совершенных (в том числе бездислокационных) монокристаллов Si и InSb; исследования процессов роста, структурных особенностей и свойств профилированных кристаллов (дендритных и междендритных лент) алмазоподобных полупроводников (Si, InSb, GaAs и ZnGeAs₂). Важные закономерности установлены при изучении поверхностных явлений в расплавах полупроводников и связи поверхностных явлений с процессами кристаллизации. Интересны результаты опытов по выращиванию легированных поверхностно активными и инактивными добавками монокристаллов Si и InSb в условиях космического пространства. Важные результаты получены при исследовании фазовых равновесий в многокомпонентных полупроводниковых системах, в том числе по строению областей твердых растворов (областей гомогенности) на основе соединений. В последние годы получены интересные данные при изучении процессов распада пересыщенных твердых растворов на основе кремния, в частности пересыщенных твердых растворов Si(Ge, O). Результаты ряда прикладных исследований внедрены в промышленное производство. Михаил Яковлевич возглавляет научную школу по фазовым и структурным превращениям, широко привлекает к этим работам научную молодежь. Под его руководством выполнено 17 кандидатских диссертаций и более 200 дипломных работ. Результаты исследований М. Я. Дашевского освещены более чем в 200 публикациях в отечественной и зарубежной литературе. М. Я. Дашевский создал ряд

спецкурсов в области фазовых и структурных превращений, теории легирования полупроводников. В соавторстве с проф. С.С. Гореликом им написано учебное пособие „Материаловедение полупроводников и металловедение“ (М., 1973 г.) и учебник „Материаловедение полупроводников и диэлектриков“ (М., 1988 г.). Учебник не имеет аналогов в отечественной и зарубежной литературе, широко используется в вузах России и стран СНГ. Михаил Яковлевич ведет большую научно-организационную работу, являясь заместителем председателя Научного совета РАН „Физико-химические основы полупроводникового материаловедения,“ председателем комиссии по материаловедению и технологии кремния Федерального фонда развития электронной техники, членом редколлегии журнала „Известия вузов. Материалы электронной техники“. Он — один из организаторов регулярных международных конференций и школ молодых ученых и специалистов по материаловедению и физико-химическим основам технологии кремния.

Мы от всей души поздравляем Михаила Яковлевича со знаменательным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в научной работе.

*Друзья и коллеги
в Физико-техническом
институте им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук*

*Редколлегия журнала
присоединяется к сердечным поздравлениям
друзей и учеников Михаила Яковлевича
и со своей стороны желает ему
творческого долголетия*